








	<h2>SI3495DV-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3495DV-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 5.3A 6-TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3495DV-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 42717 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3495DV-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 5.3A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	42717 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 5.3A (Ta) 1.1W (Ta) Surface Mount 6-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	1.1W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.3A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	24 mOhm @ 7A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	750mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±5V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI3495DV-T1-E3CT

SI3495DV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3495DV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3495DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3495DV-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3495DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 5.3A 6-TSOP</p>	 <p>SI3499DV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V 5.3A 6-TSOP</p>	 <p>SI3493DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 5.3A 6-TSOP</p>	 <p>SI3495DV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 5.3A 6-TSOP</p>
 <p>SI3499DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V 5.3A 6-TSOP</p>	 <p>SI3493DV-T1-E3. VIS SI3493DV-T1-E3. VIS</p>	 <p>SI3495DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 5.3A 6-TSOP</p>	 <p>SI3499DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 5.3A 6-TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ SI3481DV-T1-GE3	↔ SI3481DV-T1-GE3	⇒ SI3483CDV-T1-E3	D SI3483CDV-T1-E3	⇒ SI3483CDV-T1-GE3
⊕ SI3483CDV-T1-GE3	⊕ SI3483DV-T1-E3	D SI3483DV-T1-E3	⇒ SI3483DV-T1-GE3	⇒ SI3483DV-T1-GE3
⊕ SI3493BDV-T1-E3	⊕ SI3493BDV-T1-E3	⊕ SI3493BDV-T1-E3-S	↔ SI3493BDV-T1-GE3	⇒ SI3493BDV-T1-GE3
D SI3493DDV-T1-GE3	⊕ SI3493DDV-T1-GE3	⊕ SI3493DV	⊕ SI3493DV-T1	⇒ SI3493DV-T1-E3
⇒ SI3493DV-T1-E3	↔ SI3493DV-T1-E3.	⊕ SI3493DV-T1-GE3	⊕ SI3493DV-T1-GE3	⇒ SI3495DV
↔ SI3495DV-T1-E3	⇒ SI3495DV-T1-GE3	D SI3495DV-T1-GE3	⊕ SI3499DV-T1-E3	⊕ SI3499DV-T1-E3
⊕ SI3499DV-T1-GE3	D SI3499DV-T1-GE3	⇒ SI3500-A-GM	↔ SI3529DV-T1-GE3	⇒ SI3529DV-T1-GE3
⊕ SI3552DV	⊕ SI3552DV-T1	↔ SI3552DV-T1-E3	⇒ SI3552DV-T1-E3	⇒ SI3552DV-T1-GE3
⊕ SI3552DV-T1-GE3	⊕ SI3585CDV	⊕ SI3585CDV-T1-GE3	D SI3585CDV-T1-GE3	⇒ SI3585DV
↔ SI3585DV-T1	⊕ SI3585DV-T1-E3	⊕ SI3585DV-T1-E3	⊕ SI3585DV-T1-GE3	⇒ SI3585DV-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited